Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series, 2017, no. 1, pp. 25–30 25

ISSN 0002-3566 (print) УДК 539.216:546.824-31

Поступила в редакцию 01.07.2015 Received 01.07.2015

А. Т. Волочко, Г. В. Марков, В. А. Зеленин, Е. О. Нарушко

Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА СТЕКЛЯННЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

В данной статье представлены покрытия In₂O₃+SnO₂ (ITO) и ZrO₂ – Ni – ZrO₂– Cu – Ni – ZrO₂, нанесенные на стеклянные и полимерные подложки. Изучены их экранирующие свойства в оптическом и радиочастотном диапазонах длин волн.

Образцы с покрытиями 120($In_2O_3+SnO_2$) и 90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂ имеют хорошие экранирующие свойства (98 % падающего электромагнитного излучения отражается в радиочастотном диапазоне длин волн 0,7...17 ГГц). ITO-покрытие имеет низкое поверхностное электросопротивление 8...9 Ом/кв в сочетании с высоким светопропусканием (*T*~90 %). Однако для достижения таких свойств необходим нагрев ITO-подложки до температур 300...400 °C. Покрытие 90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂ имеет поверхностное электросопротивление порядка 2...3 Ом/кв и светопропускание около 60 %. Такие значения были достигнуты без нагрева подложки и, как следствие, это покрытие может быть нанесено на нетермостойкий материал, например поликарбонат. Кроме того, так как покрытие 90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂ многослойное, содержащее слои чистых металлов, с высокими электропроводностью и магнитной проницаемостью и слои ZrO₂ с высокой диэлектрической проницаемостью, то его эффективность экранирования выше, чем у покрытия из сплава ITO. Показано, что покрытия системы ZrO₂ – Ni – ZrO₂ – Cu – Ni – ZrO₂ можно использовать для защиты экрана монитора, так как оно соответствует требованиям к экранам устройств отображения информации.

Ключевые слова: покрытия, экран, электромагнитные излучения, пропускание света, эффективность экранирования.

A.T. Volochko, G.V. Markov, V.A. Zelenin, E.O. Narushko

Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

SHIELDING PROPERTIES OF OPTICAL COATINGS OBTAINED ON GLASS AND POLYMER MATERIALS

Coatings $In_2O_3 + SnO_2$ (ITO) and $ZrO_2 - Ni - ZrO_2 - Cu - Ni - ZrO_2$ deposited on glass and polymer substrates, are presented. Their shielding properties in the optical and radio frequency wavelength ranges have been studied.

Samples with coatings $120(In_2O_3+SnO_2)$ and $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$ have good shielding properties (98 % of electromagnetic emission is reflected in the range of 0.7...17 GHz). ITO-coating has low surface resistance of 8...9 ohms/ square per square in combination with high light transmittance ($T \sim 90$ %). However, in order to achieve these properties one needs to heat the substrate up to 300...400 °C. The coating $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$ has surface resistance of 2...3 ohms/square per square and light transmittance of about 60 %. These values have been obtained without heating of the substrate and, as a consequence, this coating may be deposited on temperature-sensitive materials such as polycarbonate. Moreover, since $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$ coating is a multilayer coating containing layers of pure metals that have high electric conductivity and magnetic permeability and ZrO_2 layers with high dielectric permeability it has higher shielding effectiveness than ITO alloy coating. It has been demonstrated that $ZrO_2 - Ni - ZrO_2 - Cu - Ni - ZrO_2$ coatings may be used for protection of display screens since they comply with the requirements of screens of information displays devices.

Keywords: coatings, screen, electromagnetic emission, light transmittance, shielding effectiveness.

Введение. Среди разнообразных изделий электронной техники особое место занимают устройства отображения информации: мониторы, дисплеи, жидкокристаллические индикаторы наручных часов, мобильных телефонов и др. Особенностью этих устройств является то, что, с одной стороны, эксплуатирующий их персонал находится в непосредственной близости (порядка 1 м) от информационных экранов, подвергаясь воздействию электромагнитного излучения (ЭМИ), а с другой – сами эти устройства нуждаются в защите, поскольку посредством направленного ЭМИ можно внести изменения в корректную работу компьютера, а также дистанционно считывать информацию с монитора и детектировать ее. Для защиты от излучений применяют специальные экраны и поглотители. Однако защитить лицевую часть монитора достаточно сложно,

так как оператор должен видеть изображение на экране без искажения цвета и размеров. Одним из вариантов защиты экранов является использование металлической сетки, но при этом появляются волны муара, которые снижают контрастность изображения и утомляют глаза оператора. Ослабить воздействие внешних ЭМИ можно также нанесением на стеклянные экраны оптически прозрачных электропроводящих покрытий. В качестве таких покрытий могут быть использованы пленки $In_2O_3 + SnO_2$ (indium tin oxide, ITO). Кроме того, возможно использование многослойные покрытия, состоящие из чередующихся тонких (десятки нм) металлических (Ni, Cu, Ag) и оксидных слоев (TiO₂, SiO₂, HfO₂, ZrO₂).

Покрытие системы $In_2O_3 + SnO_2$, формируемое на стекле марки K8 [1], является наиболее востребованным в настоящее время. Оксид индия относится к вырожденным полупроводникам *n*-типа [2] с широкой запрещенной зоной, концентрация электронов в нем доходит до ~1·10¹⁹ см⁻³. При легировании оксида индия четырехвалентным оловом концентрация свободных носителей заряда возрастает до ~1·10²¹ см⁻³. ITO-покрытие имеет высокое светопропускание (около 90 %) и вместе с тем благодаря высокой электропроводности хорошо защищает объект от ЭМИ.

Для обеспечения высоких экранирующих характеристик в радиочастотном диапазоне в сочетании с высокой прозрачностью – в оптическом была выбрана конструкция, которая представляет собой стеклянное основание с нанесенным на него многослойным покрытием. В результате проведения предварительных расчетов и экспериментов было выяснено, что архитектура покрытия с заданными свойствами должна соответствовать формуле (Me–Me_xO_y) *п*, то есть представлять собой чередование металлических слоев с диэлектрическими. Металл, его структура и толщина в слое должны быть такими, чтобы обеспечивать максимальное пропускание электромагнитных волн при частотах 385...750 ТГц (видимый свет) и минимальное – для частот 0,7...17 ГГц (УВЧ и СВЧ диапазоны). В соответствии с [3] пропускание *T* металлической пленкой ЭМИ рассчитывается по следующим формулам:

$$T(\omega, \Omega, \omega_{\tau}) = \frac{1}{\left(1 + \frac{(\Omega + \omega_{\tau})^2 - \omega_{\tau}^2}{\omega^2 + \omega_{\tau}^2}\right)^{1/2}},$$
(1)
$$\Omega = \pi \omega_p^2 L \sim \frac{N}{m^*},$$
(2)

где ω_{τ} – частота релаксации заряженной частицы; ω_{p} – плазменная частота; ω – частота ЭМИ; L – толщина металлической пленки; N – концентрация носителей заряда; m^{*} – эффективная масса носителей заряда.

Формула (1) позволяет оптимизировать по критерию пропускания ЭМИ заданной частоты толщину металлического слоя, тип кристаллической решетки выбираемых металлов и их структуру. Так, из (1) следует, что чем больше частота о ЭМИ, падающего на стеклянный образец с покрытием, тем больше его пропускание (прозрачность), то есть функция $T(\omega)$ является монотонно возрастающей. Функция $T(\Omega)$ – монотонно убывающая, то есть при увеличении числа носителей заряда (толщины пленки) составляющая пропускания ЭМИ уменьшается, а увеличивается процент отраженного от металлической пленки излучения [4]. Для повышения пропускания волн оптического диапазона и снижения пропускания волн радиочастотного диапазона, а также для уменьшения доли отражения световых волн поверх металлического слоя целесообразно наносить слой диэлектрика с высоким коэффициентом преломления ($n \ge 2$). Причем оптическая толщина такого просветляющего слоя должна быть кратной λ/4 для достижения минимального отражения. На основании всего изложенного следует, что толщина металлических слоев (Ni, Cu, Ag, Au) в многослойном покрытии должна быть в пределах 20...40 нм, а толщина диэлектрических (ZrO₂, SiO₂, HfO₂ и др.) – 35...100 нм. Учитывая теоретические расчеты и эксплуатационные свойства, такие как адгезия, твердость, износостойкость, коррозионная стойкость, окончательный состав покрытия соответствовал формуле 90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂, где цифры соответствуют толщинам слоев в нанометрах. Слои из металлов в покрытии обеспечивают вы-



Рис.1. Прозрачность экранов в видимом диапазоне длин волн: $120(In_2O_3 + SnO_2)/K8$ (*a*) и $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2/K8$ (*b*) Fig.1. Screen transmittance in the visible range of wavelengths: $120(In_2O_3 + SnO_2)/K8$ (*b*) and $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2/K8$ (*b*)

сокую электропроводность последних ($\rho = 2...3$ Ом/кв) и отражение электромагнитного излучения, слои же диэлектриков поглощают ЭМИ и служат просветляющими для нижележащих слоев металлов в видимом диапазоне длин волн.

Прозрачность экранов из стекла K8 с покрытиями систем $120(In_2O_3+SnO_2)/K8$ и $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2/K8$ достаточно высока и соответствует требованиям к экранам устройств отображения информации (рис. 1).

Материалы и методы исследования. Тонкие пленки оксида индия, легированного оловом, наносили на стеклянные подложки методом реактивного магнетронного распыления мишени из сплава индия (95 мас.%) и олова (5 мас.%) в атмосфере смеси кислорода и аргона. Предельное остаточное давление в камере после откачки составляло $P = (3...5) \cdot 10^{-3}$ Па, а рабочее – $P = 6 \cdot 10^{-1}$ Па. Мощность, поддерживаемая на магнетроне, была равна 1 кВт. Толщина ITO-покрытия составляла 120 нм, время непосредственного распыления мишени $\tau = 4$ мин.

Покрытие многослойной системы $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$ наносили электроннолучевым методом на установке BУ-1A с одновременным контролем толщины слоев спектрофотометром СФКТ 751 В. Давление остаточных газов было не более $7\cdot10^{-3}$ Па, ток пучка электронов – 80...120 мА, энергия электронов в пучке – более 6 кэВ. Суммарная толщина данного 6-слойного покрытия достигала величины 250 нм, время непосредственного нанесения $\tau = 4$ мин.

Перед нанесением тонкопленочных структур все подложки проходили отмывку в чистящем растворе, проточной воде, сушку и протирание техническим спиртом.

Измерение поверхностного электросопротивления осуществлялось четырехзондовым методом. При проведении измерения данным методом многослойных покрытий с диэлектрическим верхним слоем из оксида циркония перед его нанесением контактные площадки закрывали маской. Для определения экранирующих характеристик покрытий был использован панорамный измеритель коэффициентов передачи и отражения SNA 0,01-18, работающий по принципу раздельного выделения и непосредственного детектирования уровней падающей и отраженной волн.

Результаты и их обсуждение. Свойства покрытий систем 120(In₂O₃+SnO₂) и 90ZrO₂/8Ni/ 90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂ представлены в таблице.

Сравнительная характеристика оптически прозрачных покрытий экранирующих ЭМИ Comparative characteristics of optically transparent coatings EMI shielding

Показатель	$120(In_2O_3 + SnO_2)$	90ZrO ₂ /8Ni/90ZrO ₂ /22Cu/5Ni/35ZrO ₂
р, Ом/кв	10	3
R ₁ , %	35	35
T ₁ , %	85	60
Э, дБ	2937	2633
Коррозионная стойкость (на воздухе)	3000 ч без изменений	3000 ч без изменений
Адгезия	Хорошая	Хорошая

Примечание: R_1 , T_1 – коэффициенты отражения и пропускания для оптического диапазона длин волн (400...700 нм), Э – эффективность экранирования (0,01...10 м).

Из таблицы видно, что покрытие, состоящее из 95 % оксида индия и 5 % оксида олова, обладает высоким светопропусканием в видимом диапазоне длин волн (85 %). Однако для достижения электросопротивления покрытия порядка 10 Ом/кв и высокого светопропускания необходим его отжиг при $\tau \sim 350...400$ °C в вакууме после напыления, а затем выдержка на воздухе в течение нескольких суток. Процесс высокотемпературной обработки оксидной пленки позволяет атомам кислорода, внедренным между узлами кристаллической решетки или расположенным на границах зерен, диффундировать в узлы кристаллической решетки. Образующиеся кислородные вакансии действуют как доноры для электронов, увеличивая их концентрацию [5]. Следовательно, в результате отжига удельное поверхностное сопротивление оксидной пленки уменьшается как за счет увеличения концентрации электронов, так и за счет увеличения их подвижности. Данная операция накладывает ограничения по выбору основания для ITO-покрытия.

Многослойное покрытие системы $ZrO_2 - Ni - ZrO_2 - Cu - Ni - ZrO_2$ может наноситься на относительно холодные поверхности с температурой около 30...40 °C. В качестве таковых могут использоваться пластины из поликарбоната, ПВХ и других нетермостойких прозрачных материалов.

Об эффективности экранирования электронного объекта от ЭМИ в радиочастотном диапазоне длин волн можно судить по величине коэффициентов отражения K_{orp} и передачи K_{nepeq} . Данные параметры характеризуют долю отраженных и прошедших через экран электромагнитных волн соответственно:

$$K_{\rm orp} = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_0},\tag{3}$$

$$K_{\text{перед}} = 10 \cdot \lg \frac{P_2}{P_0} , \qquad (4)$$

где P_0 – падающая мощность; P_1 – мощность отраженного от экрана ЭМИ; P_2 – мощность прошедшего ЭМИ через экран.



Рис.2. Зависимости коэффициента отражения от частоты ЭМИ в диапазонах 0,7...3,0 ГГц (*a*) и 3,0...17,0 ГГц (*b*) для покрытий: *1* – 120(In₂O₂ + SnO₂); *2* – 90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/2Cu/5Ni/35ZrO₂

Fig. 2. Relationships between the reflection coefficient and the EMR frequency within the ranges of 0.7...3.0 GHz (*a*) and 3.0...17.0 GHz (*b*) for the coatings: *1*-120(In₂O₃+SnO₂); *2*-90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂



Рис. 3. Зависимости коэффициента передачи от частоты ЭМИ в диапазонах 0,7...3,0 ГГц (*a*) и 3,0...17,0 ГГц (*b*): 1 – 120(In₂O₃ + SnO₂); 2 – 90ZrO₂/8Ni/90ZrO₂/22Cu/5Ni/35ZrO₂

Fig. 3. Relationships between the transmission coefficient and the EMR frequency within the ranges of 0.7...3.0 GHz (*a*) and 3.0...17.0 GHz (*b*): $1 - 120(In_2O_3 + SnO_2)$; $2 - 90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$

Из (3) видно, что при $K_{orp} = 0$ уровень отраженной мощности ЭМИ соответствует уровню падающей ($P_1 = P_2$), что соответствует полному отражению. По мере уменьшения K_{orp} , уменьшается и часть отраженного ЭМИ. Аналогично в (4): по мере приближения K_{nepeq} к нулю растет доля прошедших электромагнитных волн через экран, то есть меньшее их количество будет задержано материалом экранирующего «щита».

Частотные зависимости коэффициентов отражения и передачи исследуемых покрытий представлены на рис. 2 и 3.

Из рис. 2, 3 видно, что из рассмотренных в данной статье систем более эффективное экранирование ЭМИ присуще покрытию системы $120(In_2O_3+SnO_2)$. Так, коэффициент отражения составляет 0...–2,5 дБ, коэффициент передачи равен – 26...–27 дБ в диапазоне 0,7...5,0 ГГц и –20...–15 дБ в диапазоне 6...17 ГГц. Однако многослойное покрытие $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$ ненамного уступает первому: в диапазоне частот 0,7...6,0 ГГц значения коэффициента отражения для данных материалов находятся на уровне –0,7...–1,5 дБ, в диапазоне 6...17 ГГц опускаются до –6,5 дБ; а коэффициента передачи –22 дБ в диапазоне 0,7....5 ГГц, –20...–13 дБ в диапазоне 5...17 ГГц.

Заключение. Установлено, что эффективность экранирования ЭМИ радиочастотного диапазона покрытия многослойной системы $90ZrO_2/8Ni/90ZrO_2/22Cu/5Ni/35ZrO_2$ практически не уступает широко применяемым прозрачным покрытиям ITO. Однако 6-слойное покрытие обладает более низким электросопротивлением ($\rho \sim 2$ Ом/кв), не требует нагрева подложки до температур порядка 300...400 °C, а только лишь не более 40 °C, что делает возможным осаждение его на прозрачные полимерные материалы. В качестве недостатка предложенной конструкции экрана можно назвать значение светопропускания, которое ниже покрытия $120(In_2O_3+SnO_2)$ на 20 %, но вместе с тем является достаточным для защиты монитора компьютера, существенно не снижая качество формируемого на нем изображения.

Список использованных источников

1. Оптически прозрачные электромагнитные экраны / А. Т. Волочко [и др.] // Доклады БГУИР. – 2015. – №3 (89). – С. 53–57.

2. Шапиро, Д. Н. Основы теории электромагнитного экранирования / Д. Н. Шапиро. – Л.: Энергия, 1975. – 112 с.

3. Курбацкий, В. П. О размерной и частотной зависимости параметров модели Друде для ультратонких металлических пленок / В. П. Курбацкий // Журн. техн. физики. – 2015. – Т. 85, вып. 5. – С. 106–109.

4. Проводящие и отражающие тонких металлических пленок / И. В. Антонец [и др.] // Журн. техн. физики. – 2004. – Т. 74, вып. 11. – С. 102–106.

5. Dawar, A. L. Semiconducting crystal display transparent thin films, their properties / A. L. Dawar, J. C. Joshi // J. Mater. Sci. - 1984. - Vol. 19, N 1. - P. 1-23.

References

1. Volochko A.T., Zelenin V.A., Markov G.V., Narushko E.O. Optically transparent electromagnetic screens. *Doklady BGUIR*, 2015, no. 3 (89), pp. 53–57. (In Russian).

2. Shapiro D.N. Basics of electromagnetic shielding theory. Leningrad, Energiya Publ., 1975, 112 p. (In Russian).

3. Kurbatsky V.P. On the size and frequency dependences of the parameters of the Drude model for ultrathin metal films. *Technical Physics*, 2015, vol. 66, no. 5, pp. 736–739. Doi: 10.1134/s1063784215050102

4. Antonets I.V., Kotov L.N., Nekipelov S.V., Karpushov E.N. Conducting and reflecting properties of thin metal films. *Technical Physics*, 2004, vol. 49, no. 11, pp. 1496–1500. Doi: 10.1134/1.1826197

5. Dawar A.L., Joshi J.C. Semiconducting crystal display transparent thin films, their properties. *Journal of Materials Science*, 1984, vol. 19, no. 1, pp. 1–23. Doi: 10.1007/bf00552989

Сведения об авторах

Волочко Александр Тихонович – доктор технических наук, профессор, заведующий отделом, Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси (ул. Академика Купревича, 10, 220141, Минск, Республика Беларусь). E-mail: volochkoat@mail.ru

Марков Геннадий Васильевич – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси (ул. Академика Купревича, 10, 220141, Минск, Республика Беларусь).

Зеленин Виктор Алексеевич – доктор технических наук, главный научный сотрудник, Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси (ул. Академика Купревича, 10, 220141, Минск, Республика Беларусь).

Нарушко Елена Олеговна – младший научный сотрудник, Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси (ул. Академика Купревича, 10, 220141, Минск, Республика Беларусь). E-mail: lena-narushko@ mail.ru

Для цитирования

Использование внешних электрических полей при доводке расплавов в плавильных агрегатах / А. Т. Волочко [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.тэхн. навук. – 2017. – № 1. – С. 25–30.

Information about the authors

Volochko Alexander Tihonovich – D. Sc. (Engineering), Professor, Department Head, Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences (10, Academician Kuprevich Str., 220141, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: volochkoat@ mail.ru

Markov Gennady Vasilevich – Ph. D. (Engineering), Senior Researcher, Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences (10, Academician Kuprevich Str., 220141, Minsk, Republic of Belarus).

ZeleninVictor Alexeyevich – D. Sc. (Engineering), Chief Researcher, Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences (10, Academician Kuprevich Str., 220141, Minsk, Republic of Belarus).

Narushko Elena Olegovna – Junior Researcher, Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences (10, Academician Kuprevich Str., 220141, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: lena-narushko@mail.ru

For citation

Volochko A.T., Markov G.V., Zelenin V.A., Narushko E.O. Shielding properties of optical coatings obtained on glass and polymer materials. *Vestsi Natsyyanal'nai akademii navuk Belarusi. Seryya fizika-technichnych navuk* [Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series], 2017, no.1, pp. 25–30. (In Russian)